

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 19 年 5 月 17 日 (2007.5.17)

【公開番号】特開 2005-277173 (P2005-277173A)
 【公開日】平成 17 年 10 月 6 日 (2005.10.6)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-039
 【出願番号】特願 2004-89494 (P2004-89494)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 23/52 (2006.01)

H 0 1 L 23/12 (2006.01)

H 0 1 L 27/14 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/88 J

H 0 1 L 23/12 5 0 1

H 0 1 L 27/14 D

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 3 月 23 日 (2007.3.23)

【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

半導体基板上に形成されたパッド電極にコンタクトするように基板裏面から開口が形成され、この開口を介して前記パッド電極に配線層が形成されて成る半導体装置において、前記開口を完全に埋め込まない程度に配線層が形成され、前記開口を含まない前記基板裏面上に保護層が形成されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

前記保護層に形成された開口部を介して露出した前記配線層上に導電電極が形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 3】

前記半導体基板上に支持体が接着されていることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の半導体装置。

【請求項 4】

半導体基板上に形成されたパッド電極にコンタクトするように基板裏面からエッチングして開口を形成し、この開口を介して前記パッド電極に接続された配線層を形成する半導体装置の製造方法において、前記開口を完全に埋め込まない程度に配線層を形成する工程と、前記開口を含まない前記基板裏面上に保護層を形成する工程とを具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 5】

前記保護層に開口部を形成して露出させた配線層上に導電電極を形成する工程を具備することを特徴とする請求項 4 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 6】

前記半導体基板上に支持体を接着する工程を具備することを特徴とする請求項 4 または請求項 5 に記載の半導体装置の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0016】

また、前記保護層に形成された開口部を介して露出させた配線層上に導電電極が形成されていることを特徴とするものである。

更に、前記半導体基板上に支持体が接着されていることを特徴とするものである。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0018】

また、前記保護層に開口部を形成して露出させた配線層上に導電電極を形成する工程を具備することを特徴とするものである。

更に、前記半導体基板上に支持体を接着する工程を具備することを特徴とするものである。